

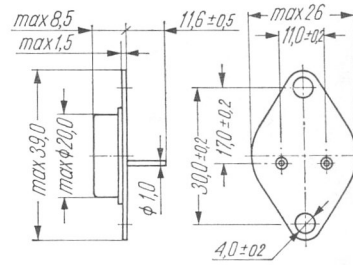
2SB468

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: HITACHI

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy dyfuzyjny
p-n-p, w obudowie metalowej TO-3

Zastosowanie: układy wyjściowe odchylenia poziomego
TV



Rys. 1-1239. 2SB468

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	max		
$U_{(BR)CBX}$	-220		V	przy $I_C = -100$ mA, $U_{EB} = -1,5$ V
$U_{(BR)CEO}$	-90		V	przy $I_C = 100$ mA, $R_{BE} = \infty$
$U_{(BR)EBO}$	-1,5		V	przy $I_E = -100$ mA, $I_C = 0$
$U_{BE sat}$		-1,0	V	przy $I_C = -4$ A, $I_B = -0,4$ A
$U_{CE sat}$		-0,4	V	przy $I_C = -4$ A, $I_B = -0,4$ A
h_{21E} (A)	14	100	}	przy $U_{CE} = -1,5$ V, $I_C = -4$ A
(B)	20	130		
(C)	25	130		
(D)	35	130		
t_f		2,5	μs	przy $I_C = -6$ A, $I_{B1} = -0,6$ A, $I_{B2} \approx +1,2$ A

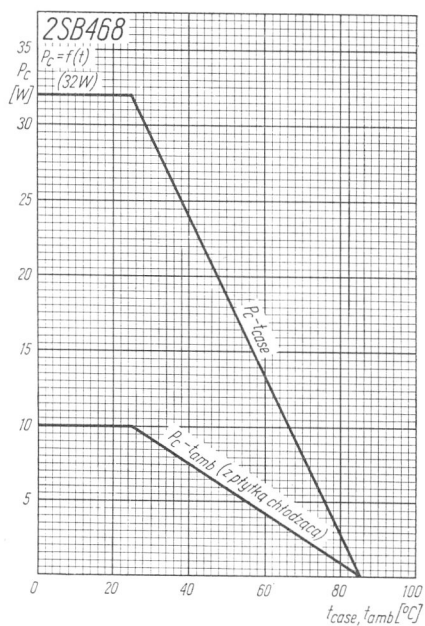
Wartości graniczne

$U_{CBX max}$	-220	V	$I_E max$	10	A
$U_{CEO max}$	-90	V	$P_{tot max}$	10 ²⁾	W
$U_{EBO max}$	-1,5	V	$P_{tot max}$	32 ³⁾	W
$I_C max$	-10	A			

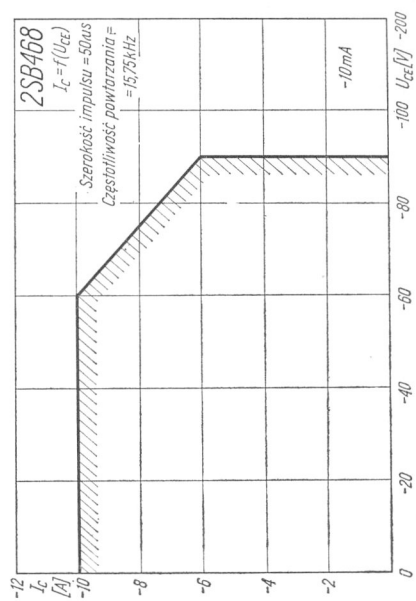
¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

²⁾ z płytką Al 300 × 200 × 1,5 mm

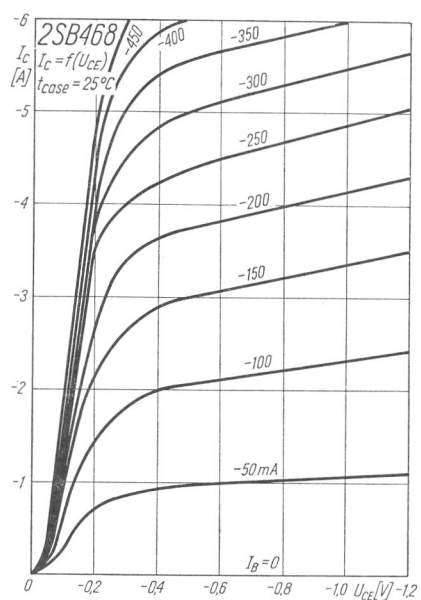
³⁾ $t_{case} = 25^\circ\text{C}$



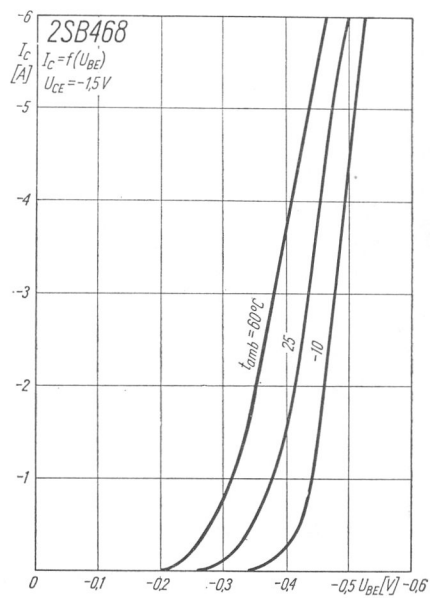
Rys. 1-1240. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



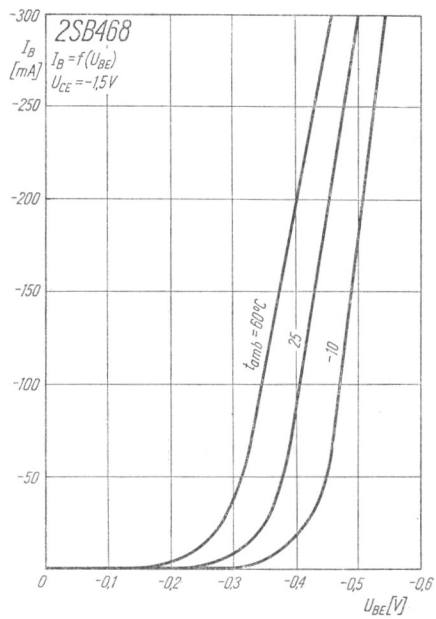
Rys. 1-1241. Dopuszczalny obszar pracy



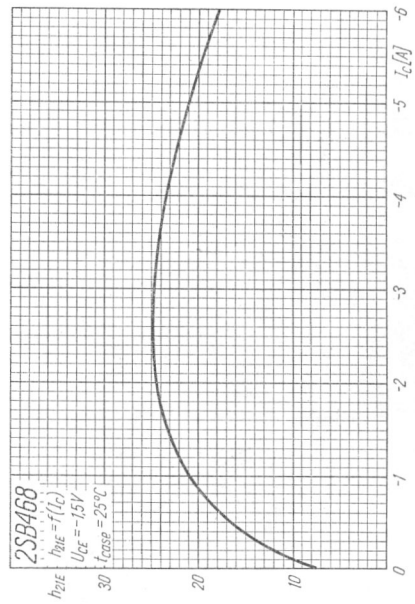
Rys. 1-1242. Charakterystyki wyjściowe



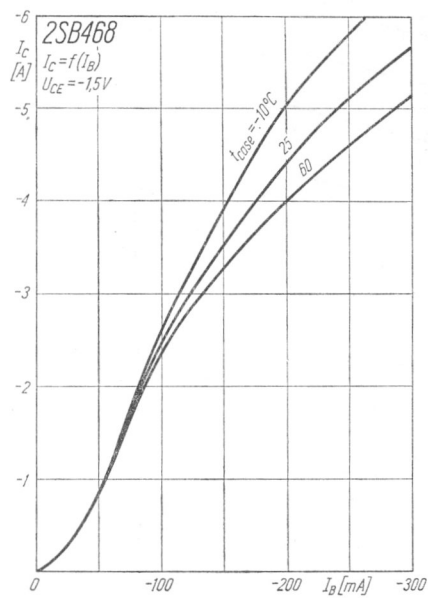
Rys. 1-1243. Charakterystyki sterowania napięciowego



Rys 1-1244. Charakterystyki wejściowe



Rys. 1-1245. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



Rys. 1-1246. Charakterystyka sterowania prądowego